



SEMINARIO

Propiedades termoeléctricas de SiC e ITO

LUIS FONSECA

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras

MIÉRCOLES 26 DE NOVIEMBRE A LAS 11:30

SALA DE SEMINARIOS
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE MATERIALES
Facultad de CC. Físicas
Universidad Complutense de Madrid

El voltaje termoeléctrico, así como las conductancias térmica y eléctrica de nanohilos pueden medirse con microdispositivos especializados. En esta charla se presentarán y discutirán los resultados de medidas hechas en nanohilos de SiC (*silicon carbide*) e ITO (*indium tin oxide*). En el caso de SiC, las medidas se relacionaron con cálculos de su estructura electrónica para obtener información sobre los procesos de dispersión de electrones y de fonones en las nanoestructuras. En el caso de ITO, se estudiaron los efectos de tratamientos térmicos en sus propiedades termoeléctricas motivados por las posibles aplicaciones a alta temperatura (>1000 °C).